PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-141124

(43)Date of publication of application: 02.06.1995

(51)Int.Cl.

G06F 3/06 G06F 3/08 G11B 17/22 G11B 19/02

(21)Application number: 05-289459

09409 (7

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

18.11.1993

(72)Inventor: MIZUKAMI MAKOTO

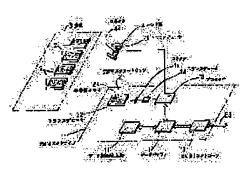
IWAZU SHIGETARO SAKAI MASAO UENO MASAHIRO

(54) LIBRARY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a library device capable of accessing data even at the time of exchanging a cartridge or the like.

CONSTITUTION: An optical disk cartridge 2 storing a recording medium is provided with a non-volatile semiconductor memory 23 and a receiving type transducer 22 for receiving power supply for driving the memory 23, a hand part 4 for carrying each cartridge between a storage 3 storing plural cartridges 2 and an optical disk drive 1 and the drive 1 are respectively provided with feeding type transducers 41, 14, and even at the time of carrying a cartridge, data are read out/written from/in the memory 23 through these transducers 41, 14. Consequently an average access time including the handling time of the cartridge 2 can remarkably be shortened.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3128035

[Date of registration]

10.11.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

rejectionj

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-141124

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int.Cl. ⁸ G 0 6 F 3/06 3/08	鐵別記号 550 F	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G11B 17/22 19/02	501 R	9296-5D 7525-5D		·
			來競查審	未請求 簡求項の数2 OL (全 7 頁)
(21)出顯番号	特顯平5-289459		(71) 出願人	000004226 日本電信電話株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)11月	118日	(72)発明者	東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 水上 誠 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日
			(72)発明者	本電信電話株式会社内 岩準 茂太郎 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内
			(72)発明者	
			(74)代理人	弁理士 吉田 精孝 ・ 最終頁に続く

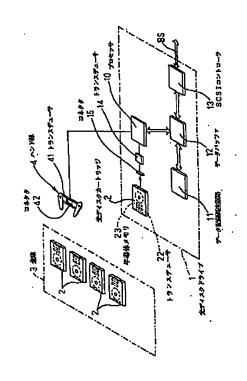
(54) 【発明の名称】 ライブラリ装置

(57)【要約】

【目的】 カートリッジ交換時等においてもデータアクセスを可能としたライブラリ装置を提供すること。

【構成】 記録媒体を収納した光ディスクカートリッジ 2に、不揮発性の半導体メモリ23と、半導体メモリに 記録されたデータを送受信し、かつ該メモリを駆動する 電源を受電するための受電型トランスデューサ22とを 設けると共に、複数のカートリッジを収納した倉庫3と 光ディスクドライブ1との間でカートリッジ2を搬送するハンド部4並びに光ディスクドライブ1に、給電型トランスデューサ41,14を設け、これらのトランスデューサを介してカートリッジ搬送時にも半導体メモリ23へのデータの読み書きを行う。

【効果】 カートリッジのハンドリング時間を含めた平均アクセス時間を大幅に短縮することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体を収納した複数のカートリッジ と、該カートリッジ内の記録媒体に対するデータの書き 込み及び読み出しを行うドライブ部と、前記複数のカー トリッジを収納する倉庫と、ドライブ部に接続するカー トリッジを前記倉庫内から搬送するハンド部とを備えた ライブラリ装置において、

前記カートリッジに、不揮発性の半導体メモリと、該半 導体メモリに記録されたデータを送受信し、かつ該メモ リを駆動する電源を受電するための受電型トランスデュ 10 ーサとを設け、

前記ハンド部に、前記カートリッジを把持している間、 前記受電型トランスデューサに接続され、前記カートリ ッジ内の半導体メモリにデータを送受信し、かつ前記半 導体メモリを駆動する電源を供給するための第1の給電 型トランスデューサを設け、

前記ドライブ部に、カートリッジが前記ドライブ部に接 続されている間、前記受電型トランスデューサに接続さ れ、前記カートリッジ内の半導体メモリにデータを送受 信し、かつ前記半導体メモリを駆動する電源を供給する 20 ための第2の給電型トランスデューサを設けると共に、 前記受電型トランスデューサに接続された第1又は第2 の給電型トランスデューサを介して前記半導体メモリへ のデータの読み書きを行うデータアクセス手段を備えた ことを特徴とするライブラリ装置。

【請求項2】 前記カートリッジを複数個収納する倉庫 は、カートリッジが倉庫に格納されている間、各カート リッジ内の前記半導体メモリにデータを送受信し、かつ 前記半導体メモリを駆動する電源を供給するための第3 ンスデューサは前記データアクセス手段に接続されてい ることを特徴とする請求項1記載のライブラリ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスク等の複数の 記録媒体を倉庫に格納し、ハンドによって自動的に記録 媒体を交換し、各記録媒体へのデータアクセスを行うラ イプラリ装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光ディスク装置は、直径90mmの光ディ 40 スク媒体で数百MB、また直径130mmの光ディスク媒 体で約1GB程度の記憶容量をそれぞれ有し、かつ光デ ィスク媒体を交換可能な記憶装置であり、光ディスク媒 体の交換により等価的に記憶要領が無限大の記憶装置を 構成できる特徴がある。

【0003】近年ではこのような光ディスク装置の特徴 を生かして、光ディスク媒体の交換を自動的に行ない1 TB級の記憶容量を提供する光ディスクライブラリ装置 が開発されている。光ディスクライブラリ装置は、光デ

ジを倉庫に多数格納し、該光ディスクカートリッジを自 動ハンドリング機構によって光ディスクドライブまで移 動し、光ディスクカートリッジ内の光ディスク媒体に対 してデータを読み書きするように構成されている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し た従来の光ディスクライブラリ装置の場合、光ディスク 媒体を交換するためには、先ず光ディスクドライブに装 填されていた光ディスクカートリッジを倉庫に戻し、次 に倉庫に格納されている光ディスクカートリッジを光デ ィスクドライブまでハンドリング、即ち搬送する必要が ある。このため、光ディスクドライブの平均アクセス時 間が数十ミリ秒と高速であるのに対して、光ディスクラ イブラリ装置の平均アクセス時間は十数秒にも達すると いう問題点があった。このように光ディスクカートリッ ジを交換する際のライブラリ装置全体の平均アクセス時 間は、記憶容量が増し倉庫の大きさが大きくなるにつれ て顕著に現れてくる。

【0005】また、光ディスクライブラリ装置の平均ア クセス時間には、光ディスク媒体の回転の停止及び起動 時間も含まれているので、データの転送速度を高めるた めに光ディスク媒体の回転数を高めると、回転の停止及 び起動時間が増大し、平均アクセス時間がさらに増加す るという問題点もあった。

【0006】本発明の目的は上記の問題点に鑑み、カー トリッジ交換時等においてもデータアクセスを可能とし たライブラリ装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達 の給電型トランスデューサを有し、該第3の給電型トラ 30 成するために、請求項1では、記録媒体を収納した複数 のカートリッジと、該カートリッジ内の記録媒体に対す るデータの書き込み及び読み出しを行うドライプ部と、 前記複数のカートリッジを収納する倉庫と、ドライブ部 に接続するカートリッジを前記倉庫内から搬送するハン ド部とを備えたライブラリ装置において、前記カートリ ッジに、不揮発性の半導体メモリと、該半導体メモリに 記録されたデータを送受信し、かつ該メモリを駆動する 電源を受電するための受電型トランスデューサとを設 け、前記ハンド部に、前記カートリッジを把持している 間、前記受電型トランスデューサに接続され、前記カー トリッジ内の半導体メモリにデータを送受信し、かつ前 記半導体メモリを駆動する電源を供給するための第1の 給電型トランスデューサを設け、前記ドライブ部に、カ ートリッジが前記ドライブ部に接続されている間、前記 受電型トランスデューサに接続され、前記カートリッジ 内の半導体メモリにデータを送受信し、かつ前記半導体 メモリを駆動する電源を供給するための第2の給電型ト ランスデューサを設けると共に、前記受電型トランスデ ューサに接続された第1又は第2の給電型トランスデュ ィクス媒体を1枚収納した標準の光ディスクカートリッ 50 一サを介して前記半導体メモリへのデータの読み書きを 行うデータアクセス手段を備えたライブラリ装置を提案 する。

【0008】また、請求項2では、請求項1記載のライ ブラリ装置において、前記カートリッジを複数個収納す る倉庫は、カートリッジが倉庫に格納されている間、各 カートリッジ内の前記半導体メモリにデータを送受信 し、かつ前記半導体メモリを駆動する電源を供給するた めの第3の給電型トランスデューサを有し、該第3の給 電型トランスデューサは前記データアクセス手段に接続 されているライブラリ装置を提案する。

[0009]

【作用】本発明の請求項1によれば、ハンド部によって 倉庫からドライブ部にカートリッジを搬送する間には、 該ハンド部に設けられた第1の給電型トランスデューサ が前記カートリッジに設けられた受電型トランスデュー サに接続され、該第1の給電型トランスデューサ及び受 電型トランスデューサを介して前記カートリッジ内の半 導体メモリに電源が供給され、且つデータアクセス手段 によって前記半導体メモリに対するデータの読み書きが 行われる。また、前記ハンド部によって前記カートリッ 20 続されている。さらに、トランスデューサ22は半導体 ジがドライブ部に装填された後は、該ドライブ部によっ て前記カートリッジ内の記録媒体に対するデータの読み 書きが行われると共に、前記受電型トランスデューサは 前記ドライブ部に設けられた第2の給電型トランスデュ ーサに接続され、該第2の給電型トランスデューサ及び 受電型トランスデューサを介して前記カートリッジ内の 半導体メモリに電源が供給され、且つ前記データアクセ ス手段によって前記半導体メモリに対するデータの読み 書きが行われる。これにより前記カートリッジをハンド リングしている間にも前記半導体メモリにアクセスする 30 ことができる。

【0010】さらに、請求項2によれば、前記カートリ ッジが前記倉庫に収納されている間は、各カートリッジ に設けられた前記受電型トランスデューサは前記倉庫に 設けられた第3の給電型トランスデューサに接続され、 該第3の給電型トランスデューサ及び受電型トランスデ ューサを介して前記カートリッジ内の半導体メモリに電 源が供給され、且つ前記データアクセス手段によって前 記半導体メモリに対するデータの読み書きが行われる。 これにより、カートリッジ内の半導体メモリが常駐され 40 る形となり、半導体メモリの配下に記録媒体が位置する ような階層構成が実現される。

[0011]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の一実施例を説 明する。図1は本発明の一実施例におけるライブラリ装 置を示す概略構成図である。図において、1は光ディス クドライブ、2は光ディスクカートリッジ、3は複数の 光ディスクカートリッジ2が収納されている倉庫、4は ハンド部で、図示せぬ機構によって倉庫3と光ディスク クカートリッジ2を把持して搬送し、光ディスクドライ プ1に装填される光ディスクカートリッジ2の交換を行 うものである。

【0012】光ディスクドライブ1は、CPUからなる プロセッサ10、データ記録再生回路11、データを一 時蓄積するデータパッファ12、SCSIコントローラ 13、給電型のトランスデューサ14及びトランスデュ ーサ14に接続されたコネクタ15を備えている。プロ セッサ10は、データバッファ12、トランスデューサ 10 14、及びハンド部4に設けられた給電型のトランスデ ューサ41のそれぞれに接続されている。さらに、デー タバッファ12は、データ記録再生回路11及びSCS 「コントローラ13に接続されている。

【0013】光ディスクカートリッジ2は、図2に示す ように、箱型の筐体20を有し、筐体20内には、光デ ィスク媒体21、受電型のトランスデューサ22、不揮 発性の半導体メモリ23及びコネクタ24, 25を備え ている。また、コネクタ24,25のそれぞれは筐体2 0の対向する面に装着され、トランスデューサ22に接 メモリ23に接続され、トランスデューサ22内の受電 回路22aを介して半導体メモリ23に電源が供給さ れ、ラインドライバ22b及びラインレシーバ22cを 介してデータアクセスが行われる。

【0014】また、トランスデューサ14は、図2に示 すように、電源供給回路14a、ラインドライバ14b 及びラインレシーバ14cから構成され、これらはコネ クタ15、24或いはコネクタ15、25を介して、ト ランスデューサ22の受電回路22a、ラインレシーバ 22 c、ラインドライバ22 b に記述の順に接続される ようになっている。

【0015】一方、ハンド部4に備わるトランスデュー サ41も、前述したトランスデューサ22と同様に、電 源供給回路、ラインドライバ及びラインレシーバから構 成され、これらはコネクタ42、24或いはコネクタ4 2,25を介して、トランスデューサ22の受電回路2 2a、ラインレシーバ22c、ラインドライバ22bに 記述の順に接続されるようになっている。

【0016】このように、本実施例では、光ディスクカ ートリジ2内の半導体メモリ23はシリアルインタフェ ースを有しており、ハンド部4若しくは光ディスクドラ イブ1と光ディスクカートリッジ2内の半導体メモリ2 3との間のデータの送受信は双方向のシリアルインタフ ェースで行なわれるように構成されている。

【0017】また、光ディスクカートリッジ2は、ハン ド部4及び光ディスクドライブ1と接続するための少な くとも異なる2ケ所に設けられたコネクタ24,25に よって、光ディスクカートリッジ2の交換の際にも連続 して半導体メモリ23をアクセスできるようになってい ドライブ1との間を移動し、倉庫3から任意の光ディス 50 る。例えば、光ディスクカートリッジ2がハンド部4に

よって把持されて搬送されている間には、コネクタ25 とコネクタ42が接続され、また光ディスクカートリッ ジ2が光ディスクドライブ1に装填されている間には、 コネクタ24とコネクタ15が接続され、半導体メモリ 23のアクセスが可能になっている。

【0018】前述したシリアルインタフェースによるデ ータの送受信は、通信線数を少なくでき、コネクタ1 5, 24, 25, 42を簡易に構成できるため、通信の 信頼性が高く、また光ディスクカートリッジ2に搭載さ れたラインドライバ22b、ラインレシーバ22c、半 10 導体メモリ23の消費電力を低減できる意味でも有効で ある。

【0019】尚、半導体メモリ23の電源は、ハンド部 4若しくは光ディスクドライブ1に搭載されたトランス デューサ14, 41の電源供給回路14aから供給さ れ、光ディスクカートリッジ2内の受電回路22aによ ってノイズが除去されると共に電圧が調整されて半導体 メモリ23に供給される。

【0020】前述の構成によれば、光ディスク媒体21 にデータを記憶する場合には、SCSIバスBSを介し 20 導体メモリ23がキャッシュメモリとして機能するため て上位装置 (図示せず) から送られてきたデータを一旦 データバッファ12に蓄積し、プロセッサ10の管理の もとで光ディスク媒体21の回転のタイミングにあわせ てデータ記録再生回路11に送り、データ記録再生回路 11によって光ディスク媒体21にデータが記録され る。また、光ディスク媒体21からデータを読み出す場 合は、前述したとは逆の過程を経てSCSIバスBSを 介して上位装置にデータが出力される。

【0021】一方、半導体メモリ23にデータを記録す る場合には、データはデータバッファ12から一旦プロ 30 セッサ10に取り込まれ、プロセッサ10のシリアルイ ンタフェースからトランスデューサ14若しくはハンド 部4に搭載されたトランスデューサ41を介して光ディ スクカートリッジ2内の半導体メモリ23に転送され る。即ち、半導体メモリ23にデータを記録する場合に は、プロセッサ10によって、ハンド部4若しくは光デ ィスクドライプ1側のラインドライバ15b, 41bか ら光ディスクカートリッジ2内のラインレシーバ22c に向けてデータが転送され、半導体メモリ23にデータ

【0022】さらに、半導体メモリ23からデータを読 み出す場合は、光ディスクカートリッジ2内のラインド ライバ22bからハンド部4若しくは光ディスクドライ プ1側のラインレシーバ14cにデータが転送され、プ ロセッサ10によりデータの読み出しが行われ、該読み 出されたデータはデータバッファ12及びSCSIコン トローラ13を介してSCSIバスBSに出力される。 【0023】また、光ディスクカートリッジ2内の光デ ィスク媒体2.1は、光ディスクドライブ1に装填された 後、起動されて所定の回転速度で回転されている間にア 50 【0029】尚、本実施例の場合、データの送受信に関

クセス可能となるが、半導体メモリ23の場合は光ディ スクカートリッジ2が搬送されている間、若しくは光デ ィスクカートリッジ2が光ディスクドライブ1に装填さ れ、光ディスク媒体21が起動及び停止の過程にある間 にもアクセス可能である。

【0024】従って、半導体メモリ23を光ディスク媒 体21のキャッシュメモリとして使用すると、光ディス クドライブ1単体のアクセス性能を向上できるばかりで なく、カートリッジ交換を含む平均アクセス時間を1/ 3に短縮できる。

【0025】これは、光ディスクカートリッジ2を搬送 する3つのハンドリング行程、即ち記録再生処理が完了 した光ディスクカートリッジ2を光ディスクドライブ1 から倉庫3に搬送する第1の行程と、ハンド部4を次の 光ディスクカートリッジ2に向けて移動させる第2の行 程と、新しい光ディスクカートリッジ2を倉庫3から光 ディスクドライブ1に搬送する第3の行程のうち、光デ ィスクカートリッジ2をハンドリングしている第1及び 第3の行程において、光ディスクカートリッジ2内の半 である。

【0026】さらに、本実施例ではキャッシュメモリを 構成する半導体メモリ23と光ディスク媒体21が共に 筺体20内に収納されているため、光ディスクカートリ ッジ2を交換するとキャッシュデータが自動的に保存さ れることになる。従って、光ディスクカートリッジ2の 交換直後もキャッシュメモリ中のデータのヒット率を髙 く維持できるという特徴がある。

【0027】また、動画像データを光ディスク媒体21 に記録した場合には、該動画像データの頭だしデータを 半導体メモリ23に記録しておけば、光ディスクカート リッジ2をハンドリングした瞬間からデータを再生でき るため比較的高速な頭出しが可能になる。さらにまた、 従来のように頭だし専用のメモリを使用しないことか ら、頭だし部分の登録が不要であり、ライブラリ装置に 対して光ディスクカートリッジ2を容易に追加・削除で きる特徴もある。

【0028】前述したように光ディスクカートリッジ2 内に光ディスク媒体21と共に不揮発性の半導体メモリ 40 23を搭載し、該半導体メモリ23を光ディスク媒体2 1のキャッシュメモリとして使用すれば、光ディスクド ライブ1単体のアクセス性能を飛躍的に向上することが できる。また、半導体メモリ23を光ディスク媒体21 の交替エリアとして使用することも可能である。この場 合、光ディスク媒体21に欠陥セクタがある場合でもへ ッドを移動させて交替処理を行なう必要がないため、動 画像のように連続した長大データの記録再生や、複数の 光ディスクドライブ1を同期して運転する光ディスクア レイを構成する上で極めて有効である。

してはワイヤ(導電配線)を使ったシリアルインタフェ ースを使用しており、光ディスクカートリッジ2内の半 導体メモリ23を駆動する電源も同一のワイヤを用いて 供給しているが、データの送受信や電源の供給には、こ の他に光カプラ、磁気カプラ等が使用できることは言う までもないことである。

【0030】次に、本発明の第2の実施例を説明する。 図3は本発明の第2の実施例を示す構成図である。図に おいて、前述した第1の実施例と同一構成部分は同一符 **身をもって表しその説明を省略する。また、第1の実施 10 ので、動画像データの同期記録再生や複数のドライブ部** 例と第2の実施例の相違点は、第1の実施例の構成に加 えて、倉庫3にプロセッサ10に接続された給電型のト ランスデューサ31及び各光ディスクカートリッジ2に 対応した複数のコネクタ32を設け、トランスデューサ 31及びコネクタ32を介して倉庫に収納されている複 数の光ディスクカートリッジ2内の半導体メモリ23 を、プロセッサ10からアクセスできるようにしたこと にある。この場合、光ディスクカートリッジ2と倉庫3 のシリアルインタフェースの接続は、光ディスクドライ ブ1において用いたものと同様のものが使用されてい

【0031】本実施例によれば、光ディスクライブラリ 装置において、光ディスクカートリッジ2内の半導体メ モリ23が常駐される形となり、図4に示すように半導 体メモリ23の配下に光ディスク媒体21が位置するよ うな階層構成となる。但し、半導体メモリ23と光ディ スク媒体21間のインタフェースが光ディスクドライブ 1の数によって制限されるのは言うまでもない。

【0032】従って、半導体メモリ23に動画像データ のインデックスデータ、或いは間引きデータ等を書き込 30 んでおけば、光ディスク媒体21に直接アクセスするこ となく、動画像データを検索したり早送り再生したりす ることができる。

【0033】このような前処理を経て所望の光ディスク 媒体21及び所望のトラック位置を検索してからハンド 部4を駆動して光ディスクカートリッジ2を光ディスク ドライブ1に装填し、詳細な画像データ等を光ディスク 媒体21から再生することになる。これにより本構成の 場合、新たな光ディスクカートリッジ2を追加する場合 にもインデックス情報をライブラリ装置に登録する必要 40 カートリッジ、20…箇体、21…光ディスク媒体、2 がないため、光ディスクカートリッジ2を極めて容易に 追加、削除することが可能となる。

【0034】尚、前述した実施例においては記録媒体と して光ディスク媒体21を用いたが、これに限定される ことはなく、光ディスク媒体21に代えて磁気ディスク 媒体、光磁気ディスク媒体、磁気テープ媒体等を記録媒 体として用いることができることは言うまでもないこと

である。

[0035]

【発明の効果】以上説明したように本発明の請求項1に よれば、半導体メモリを記録媒体と共にカートリッジ内 に収納し、前記カートリッジをハンドリングしている間 にも前記半導体メモリにアクセスすることができるよう にしたので、前記カートリッジのハンドリング時間を含 めた平均アクセス時間を大幅に短縮することができる。 また、前記半導体メモリを使って高速に交替処理できる を同期して運転する光ディスクアレイ装置等のアレイ装 置を容易に構成することができる。さらに、容易にアク セスできる前記半導体メモリに記録媒体のインデックス 情報等を記録すれば、ライブラリ装置への前記記録媒体 の登録が不要となり、カートリッジの追加・削除を容易 に行なうことができる。

【0036】また、請求項2によれば、上記の効果に加 えて、カートリッジ内の半導体メモリが常駐される形と なり、半導体メモリの配下に記録媒体が位置する階層構 20 成が実現されるので、半導体メモリに例えば記録媒体に 記録されている動画像データのインデックスデータ、或 いは間引きデータ等を書き込んでおけば、記録媒体に直 接アクセスすることなく、動画像データを検索したり早 送り再生したりすることができるという非常に優れた効 果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例におけるライブラリ装置 を示す概略構成図

【図2】本発明の第1の実施例における光ディスクカー トリッジを示す概略構成図

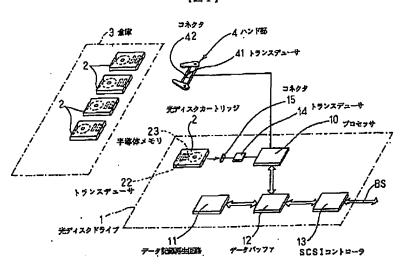
【図3】本発明の第2の実施例を示す概略構成図

【図4】本発明の第2の実施例におけるメモリの階層構 造を示す図

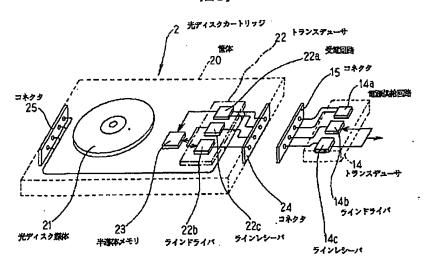
【符号の説明】

1…光ディスクドライブ、10…プロセッサ、11…デ ータ記録再生回路、12…データパッファ、13…SC SIコントローラ、14…給電型のトランスデューサ、 14a…電源供給回路、14b…ラインドライバ、14 c…ラインレシーパ、15…コネクタ、2…光ディスク 2…受電型のトランスデューサ、22a…受電回路、2 2 b … ラインドライバ、22 c … ラインレシーバ、23 …不揮発性の半導体メモリ、24, 25…コネクタ、3 …倉庫、31…給電型のトランスデューサ、32…コネ クタ、4…ハンド部、41…給電型のトランスデュー サ、42…コネクタ。

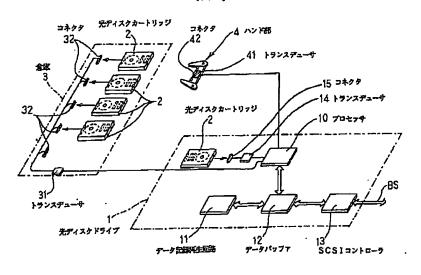
[図1]



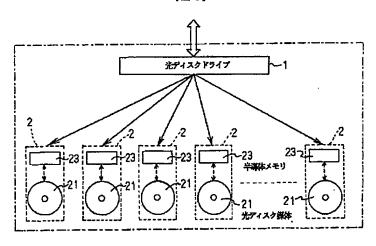
【図2】



【図3】



[図4]



フロントページの続き

(72)発明者 上野 雅浩 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内